

# Samsung délivre ses composants DDR4 3200 MHz gravés en 10 nm

**Samsung** vient de lancer la production de composants mémoire gravés en **10 nm**. Un véritable défi pour l'industriel asiatique, tant la mise au point de processus de lithographie en 10 nm s'est révélée complexe.

« La DRAM 10 nm Samsung permettra un plus haut niveau d'efficacité pour les systèmes informatiques, devenant ainsi un nouveau moteur de croissance pour l'industrie mondiale de la mémoire », déclare **Young-Hyun Jun**, président du business mémoire chez Samsung. « Dans un avenir proche, nous allons également lancer la prochaine génération de produits DRAM **mobiles** en 10 nm. »

Les premiers composants DRAM en 10 nm prennent la forme de puces de **DDR4** d'une capacité de 8 Gb (1 Go). Première différence par rapport à la DRAM 20 nm, la vitesse, qui passe de 2400 MHz à **3200 MHz**, soit un gain d'un tiers. Mais ce n'est pas tout. Les besoins en énergie baissent également de **10-20 %**. Enfin, le taux d'utilisation des wafers grimpe de 30 %, ce qui devrait participer à abaisser les coûts de production. Du tout bon donc pour Samsung.

## De 4 Go à 128 Go

Ces nouvelles puces de DRAM permettront de créer des modules allant de **4 Go**, pour le monde des ordinateurs portables, à **128 Go**, pour les serveurs de haut de gamme, indique la firme.

Les composants DRAM sont plus complexes à mettre au point que les puces Flash NAND. Samsung propose ainsi de la NAND Flash en 10 nm depuis 2013. Aussi, l'arrivée du 10 nm est de bon augure pour la mise au point de composants plus complexes, **comme des processeurs**.

### À lire aussi :

[Samsung présente un SSD 2,5 pouces de 15 To !](#)

[Semi-conducteur : Samsung passe à la gravure 14 nm next gen](#)

[Samsung met 8 coeurs dans ses puces mobiles de milieu de gamme](#)